


**PHOTOINTERRUPTERS
Transmit type**
SG-215

SG-215は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組み合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した、汎用インタラプタです。

The SG-215 photointerrupter high-performance standard type, combines high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor.

特長 FEATURES

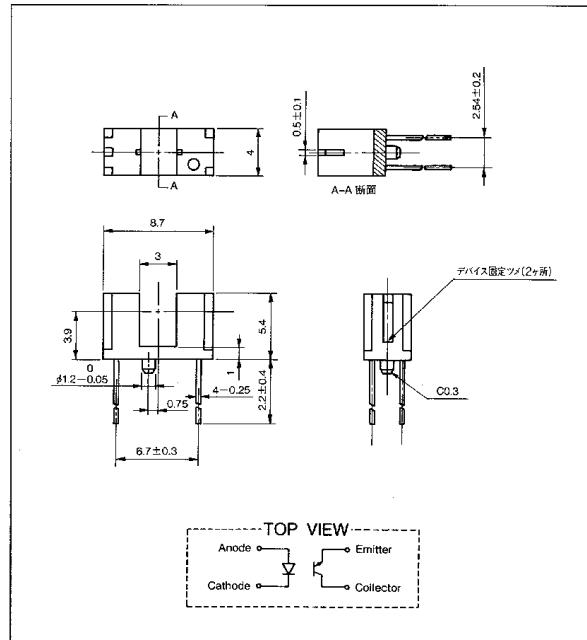
- 高精度位置検出
- 高速応答
- 受光間ギャップが広い。
- 広範囲への応用が可能。
- High performance
- High-speed response
- 5mm gap.
- Widely applicable

用途 APPLICATIONS

- テープエンド・センサ
- タイミング・センサ
- エッジ・センサ
- 複写機
- Tape-end sensors
- Timing sensors
- Edge sensors
- Copiers

電気的光学的特性**ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS**

Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入力 Input	順電圧 Forward voltage	V_F	$I_F=30\text{mA}$		1.2	1.5	V
	逆電流 Reverse current	I_R	$V_R=5\text{V}$			10	μA
	端子間容量 Capacitance	C_t	$V=0, f=1\text{KHz}$		25		pF
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ_p			940		nm
出力 Output	暗電流 Collector dark current	I_{CEO}	$V_{CE}=10\text{V}$			0.1	μA
	光電流 Light current	I_L	$V_{CE}=5\text{V}, I_F=20\text{mA}$	0.7		14	mA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage		$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{mA}, I_c=0.1\text{mA}$			0.4	V
応答時間 Switching speeds	立ち上り時間 Rise time	tr	$V_{CC}=10\text{V}$ $I_c=0.5\text{mA}$		10		$\mu\text{sec.}$
	立ち下り時間 Fall time	tf	$R_L=100\Omega$		15		$\mu\text{sec.}$

外形寸法 DIMENSIONS (Unit:mm)**最大定格 MAXIMUM RATINGS**

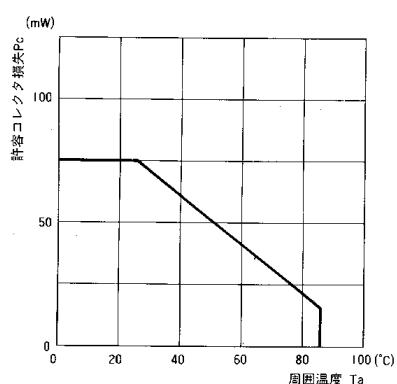
(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power dissipation	P_D	75	mW
	逆電圧 Reverse voltage	V_R	5	V
	順電流 Forward current	I_F	50	mA
	パルス順電流 Pulse forward current ^{*1}	I_{FP}	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P_C	75	mW
	コレクタ電流 Collector current	I_C	20	mA
	コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage	V_{CEO}	30	V
	コレクタ・エミッタ間電圧 E-C voltage	V_{ECO}	5	V
動作温度 Operating temp.		$T_{opr.}$	-20~+75	°C
保存温度 Storage temp.		$T_{stg.}$	-40~+75	°C
半田付温度 Soldering temp. ^{*2}		$T_{sol.}$	240	°C

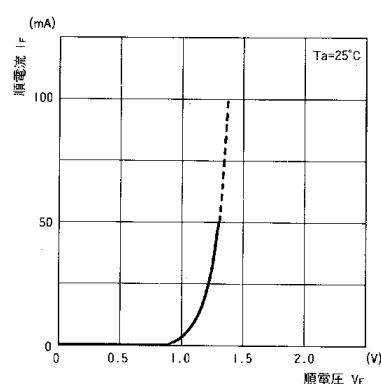
*1 $t_w=100\mu\text{sec.}, T=10\text{msec.}$ *2 リード根元より2mm離れた所で、 $t=5\text{sec.}$

(Ta=25°C)

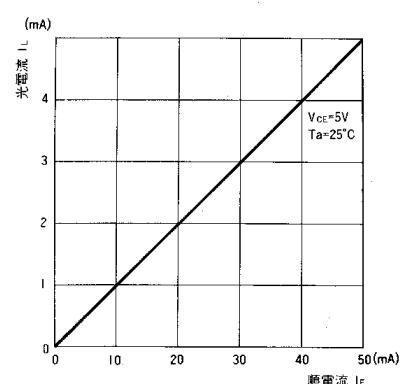
■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a



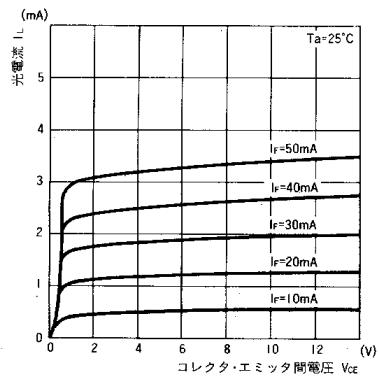
■順電流/順電圧特性 I_F/V_F



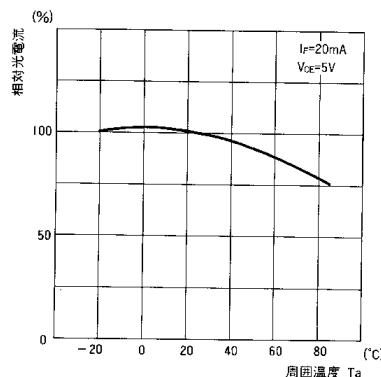
■光電流/順電流特性 I_L/I_F



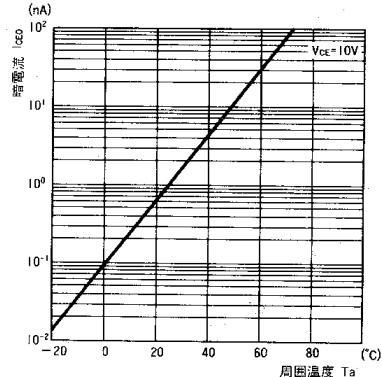
■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}



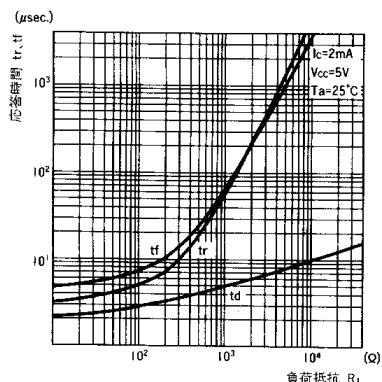
■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a



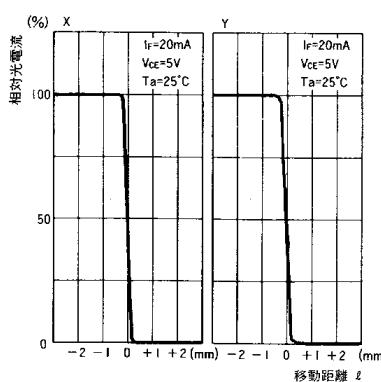
■暗電流/周囲温度特性 I_{CEO}/T_a



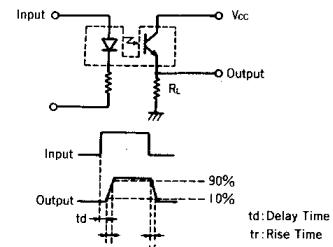
■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ *1



■位置検出特性 *2



*1 応答時間測定条件



*2 位置検出特性測定方法

